

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公開番号】特開2010-251632(P2010-251632A)

【公開日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-044

【出願番号】特願2009-101679(P2009-101679)

【国際特許分類】

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/78 (2006.01)

H 01 L 29/739 (2006.01)

H 01 L 21/66 (2006.01)

H 01 L 21/318 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 5 8 G

H 01 L 29/78 6 5 5 B

H 01 L 29/78 6 5 8 F

H 01 L 29/78 6 5 8 Z

H 01 L 29/78 6 5 8 A

H 01 L 29/78 6 5 5 C

H 01 L 29/78 6 5 2 L

H 01 L 29/78 6 5 2 M

H 01 L 29/78 6 5 8 L

H 01 L 29/78 6 5 5 F

H 01 L 21/66 B

H 01 L 21/318 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月29日(2012.2.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

以下の工程を含む半導体装置の製造方法：

(a) 第1の厚さを有する半導体ウエハの第1の主面上に、第1の金属膜を形成する工程；  
 (b) 前記工程(a)の後、前記半導体ウエハの第2の主面側に対して、バック・グラインディング処理を実行することにより、前記第1の厚さよりも薄い第2の厚さとする工程；  
 (c) 前記工程(b)の後、前記半導体ウエハの前記第2の主面上に、その周辺に沿って、第1の絶縁膜からなり、前記第2の主面の周辺に沿う円環状絶縁膜パターンを含む絶縁膜パターンを形成する工程；

(d) 前記絶縁膜パターンがある状態で、前記円環状絶縁膜パターンの開口部の厚さを前記第2の厚さよりも薄い第3の厚さとする工程；

(e) 前記工程(d)の後、前記絶縁膜パターンがある状態で、前記半導体ウエハに対して、電気的テストを実行する工程；

(f) 前記工程(e)の後、前記絶縁膜パターンがある状態で、前記半導体ウエハの前記第2の主面を粘着シートに貼り付けることにより、前記粘着シートを介してダイシング・

フレームに保持させる工程；

(g) 前記工程(f)の後、ダイシング・フレームに保持された状態で、前記半導体ウエハを個々のチップに分割する工程。